

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成21年7月30日(2009.7.30)

【公開番号】特開2008-4893(P2008-4893A)

【公開日】平成20年1月10日(2008.1.10)

【年通号数】公開・登録公報2008-001

【出願番号】特願2006-175611(P2006-175611)

【国際特許分類】

H 01 L 29/786 (2006.01)

H 01 L 21/336 (2006.01)

H 01 L 21/02 (2006.01)

H 01 L 27/12 (2006.01)

G 06 K 19/077 (2006.01)

G 06 K 19/07 (2006.01)

B 42 D 15/10 (2006.01)

【F I】

H 01 L 29/78 6 1 9 A

H 01 L 29/78 6 1 3 Z

H 01 L 29/78 6 2 7 D

H 01 L 27/12 B

G 06 K 19/00 K

G 06 K 19/00 H

B 42 D 15/10 5 2 1

【手続補正書】

【提出日】平成21年6月12日(2009.6.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】半導体装置

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板上に設けられた素子形成層と、

前記素子形成層上に設けられた記憶素子部と、

前記素子形成層上に設けられたアンテナとして機能する導電層と、

前記素子形成層、前記記憶素子部および前記導電層上に設けられた樹脂層と、を有し、

前記導電層の膜厚に対する、前記素子形成層および前記記憶素子部上の前記樹脂層の膜厚の膜厚比は、1.2以上であり、

前記導電層の膜厚に対する、前記導電層上の前記樹脂層の膜厚比は、0.2以上であることを特徴とする半導体装置。

【請求項2】

請求項1において、

前記樹脂層は、エポキシ樹脂からなることを特徴とする半導体装置。

【請求項3】

請求項1または請求項2において、

前記基板は、膜厚が2μm以上20μm以下であることを特徴とする半導体装置。

【請求項4】

請求項1乃至請求項3のいずれか1項において、

前記基板は、ポリプロピレンからなるフィルム、ポリエステルからなるフィルム、ビニルからなるフィルム、ポリフッ化ビニルからなるフィルム、塩化ビニルからなるフィルム、繊維質な材料からなる紙、基材フィルム(ポリエステル、ポリアミド、無機蒸着フィルム、紙類等)と接着性合成樹脂フィルム(アクリル系合成樹脂、エポキシ系合成樹脂等)との積層フィルムの、いずれかであることを特徴とする半導体装置。